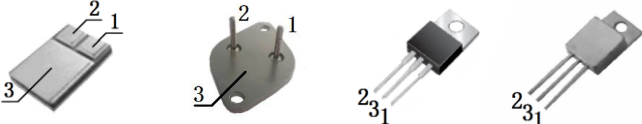


3DD99(3DD100)型 NPN 硅低频大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值					单位
			A	B	C	D	E	
极 限 值	P_{CM}	$T_c=75^{\circ}C$	20					W
	I_{CM}		1.5					A
	T_{jm}		175					$^{\circ}C$
	T_{stg}		-55~150					$^{\circ}C$
	R_{th}	$V_{CE}=10V$ $I_C=0.5A$	5					$^{\circ}C/W$
直 流 参 数	$V_{(BR)CBO}$	$I_{CE}=1mA$	≥ 150	≥ 200	≥ 250	≥ 300	≥ 350	V
	$V_{(BR)CEO}$	$I_{CE}=1mA$	≥ 100	≥ 150	≥ 200	≥ 250	≥ 300	V
	$V_{(BR)EBO}$	$I_{EB}=1mA$	≥ 5.0					V
	I_{CBO}	$V_{CB}=50V$	≤ 0.5					mA
	I_{CEO}	$V_{CE}=30V$	≤ 0.2					mA
	I_{EBO}	$V_{EB}=3V$	≤ 2.0					mA
	V_{BEsat}	$I_C=1.0A$	≤ 1.8					V
	V_{CEsat}	$I_B=0.1A$	≤ 1.0					
	h_{FE}	$V_{CE}=5V$ $I_C=0.5A$	20~120					
外 引 线 说 明	 SMD-1 B2-01B(F1) TO-220 TO-257 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极							
替代型号:								